

ナノテク素材の代表であるカーボンナノチューブ（筒状炭素分子）の産業応用に結びつきそうな研究成果を、国内の大学が相次ぎ発表した。高速メモリーや触媒などこれまでなじみの薄かった分野で、実用レベルの性能を実現した。日本人が発見したナノチューブを、日本の産業競争力向上に結びつけられるかが今後の課題となりそうだ。

中央大学の竹内健教授らは米ナノテクベンチャーのナンテロ（マサチューセッツ州）と共同で、ナノチューブを使った高速メモリー「NRAM」を開発した。1トビが記憶できる試作品で、高速で

が相次ぎ発表した。高速メモリーや触媒などこれまでなじみの薄かった分野で、実用レベルの性能を実現した。日本人が発見したナノチューブを、日本の産業競争力向上に結びつけられるかが今後の課題となりそうだ。

ハワイで今月開いた半導体の国際会議で発表して注目を集めた。

NRAMはナノチューブを固めた層を2枚の電極で挟んだ。電圧がかかるとナノチューブ同士が

接触する速さだ。電流は次世代として開発が進むMRAM（磁気記録式メモリ）の半分以下だ。10分

書き込み、電源を切ってもデータが消えない。米

DRAM（記憶保持動作）を固めた層を2枚の電極で挟んだ。電圧がかかるとナノチューブ同士が

カーボンナノチューブ応用

高速メモリー・触媒にも

引き合って抵抗が下がる。電気を流すと熱の振動でナノチューブ同士が離れて抵抗が上がる。抵抗の違いでデータを記憶する。

データは20倍（今は100万分の1）以下

00万分の1以下

00万分の1以下